







	<h2 style="color: #E67E22;">FQD10N20LTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD10N20LTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD10N20LTM.pdf</a> <a href="#">2.FQD10N20LTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9110 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD10N20LTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9110 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 51W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	830pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD10N20LTM ist neu im Original, Suche FQD10N20LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD10N20LTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD10N20LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQD10N20LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK	 <b>FQD10N20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK	 <b>FQD10N20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK	 <b>FQD10N20TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK
 <b>FQD10N20LTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK	 <b>FQD10N20D</b> F FQD10N20D F	 <b>FQD10N20TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK	 <b>FQD10N20CTM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD10N20	↔ FQD10N20C	⇒ FQD10N20CTF	D FQD10N20CTF	⇒ FQD10N20CTM
⊣ FQD10N20CTM	⊗ FQD10N20D	D FQD10N20L	⇒ FQD10N20LTF	⇒ FQD10N20LTF
⊗ FQD10N20LTM	⊣ FQD10N20TF	⊗ FQD10N20TF	↔ FQD10N20TM	⇒ FQD10N20TM
D FQD11P06	⊗ FQD11P06-NL	⊣ FQD11P06TF	⊗ FQD11P06TF	⇒ FQD11P06TM
⇒ FQD11P06TM	↔ FQD12N10	⊗ FQD12N20	⊣ FQD12N20L	⇒ FQD12N20LTF
↔ FQD12N20LTF	⇒ FQD12N20LTM	D FQD12N20LTM	⊗ FQD12N20TF	⊣ FQD12N20TF
⊗ FQD12N20TM	D FQD12N20TM	⇒ FQD12P10	↔ FQD12P10TF	⇒ FQD12P10TF
⊣ FQD12P10TM	⊗ FQD12P10TM	↔ FQD13N06	⇒ FQD13N06L	⇒ FQD13N06LTF
⊗ FQD13N06LTF	⊣ FQD13N06LTM	⊗ FQD13N06LTM	D FQD13N06LTM-NL	⇒ FQD13N06TF
↔ FQD13N06TF	⊗ FQD13N06TM	⊣ FQD13N06TM	⊗ FQD13N10	⇒ FQD13N10L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited